Schriftl. Prüfung / Beispiel 1

Nachrichtentechnik Hochschule Mannheim

Fach: Höchstfrequenztechnik (HT)

Tag: drei Aufg. aus verschiedenen Terminen Hilfsmittel: Vorlesungsmitschrift, Rechner, Bücher LWL I,II

Semester 8N

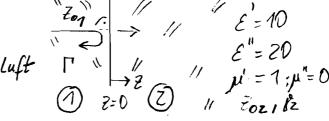
Aufgabensteller: Prof. Dr. Timmermann

Name:

Bearbeitungszeit 2 h

Aufg. 1 Zu untersuchen sind Reflexion und Transmission der senkrecht einfallenden ebenen Welle.

- a) Berechnen Sie die komplexen Wellenwiderstände Z_{01,2} zahlenmäßig.
- b) Wie groß ist der komplexe Reflexionsfaktor Γ betragsmäßig?

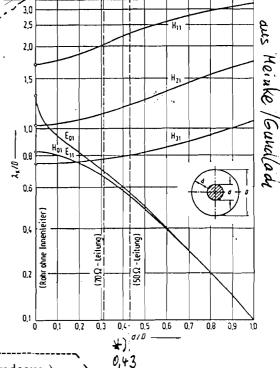


- c) Ermitteln Sie den reflektierten und in Bereich 2 den transmittierten Leistungsbruchteil.
- d) Man bestimme γ_2 =j β_2 zahlenmäßig nach Real- und Imag.-teil für f= 300 THz. Nach welcher Strecke ist die elektrische Feldstärke E auf 1/e abgefallen?
- e) Welches λ_2 würde sich im Bereich 2 errechnen sich, wenn ε " = 0 wäre?

<u>Aufg.3</u> Zu dimensionieren ist in a) u. b) ein luftgefülltes Koaxialkabel, das bis 46 GHz monomode ist und 50 Ω Wellenwiderstand der TEM-Grundwelle hat. Dafür gilt in Frage a) u. b) d/D = 0.43.

Mit steigender Frequenz werden nach der TEM-Welle (f_c=0) erwartungsgemäß höhere Wellentypen mit ansteigenden Grenzfrequenzen fc ausbreitungsfähig. Für Grenzfrequenz f_c und Grenzwellenlänge λ_k des jeweiligen Wellentyps gilt im Diagramm die Umrechnung: $\lambda_k = c_0/f_c$.

- a) Benennen Sie mit aufsteigender Frequenz die jeweiligen λ_k/D -Werte der ersten 6 Wellentypen, die nach der TEM- Welle (f_c^{TEM}=0) ausbreitungsfähig werden.
- b) Man bestimme d und D, wenn erst bei 46 GHz die H₁₁-Welle ausbreitungsfähig werden soll.
- c) Nun sei mit d/D=0 ein Hohlleiter gegeben. Wie groß ist λ_k^{H11}/D laut Diagramm? Schreiben Sie die f_c^{H11} -Formel der Vorlesung auf λ_k^{H11}/D um. Man vergleiche den Wert.



Aufg. 3 Zu untersuchen ist ein sehr spezieller optischer (Geradeaus-) Empfänger mit Intensitätsmodulation durch ein harmonisches Signal im Basisband 0.. B_H.

- a) Geben Sie entsprechend Vorlesung das Signal-zu-Rausch-Verhältnis S/N in nicht normierter Form für Empfang mit einer PIN-Photodiode an.
- b) Spezialisieren Sie auf $I_D >> I_0$ (Dunkelstrom $I_D >> Primärphotostrom <math>I_0$), und geben Sie die erforderliche optische DC-Leistung Po als Fktn. von Modulationsgrad m, Störabstand S/N, Empfangsbandbreite B_H und äquivalentem Verstärkerrauscheffektivwert $\sqrt{I_{\alpha\alpha}^2(t)}$ an.
- c) Nehmen Sie weiter gleichzeitig an: a) m = 100 %, b) weißes Rauschen und c) S/N = 1. Wie lautet dann die durch NEP = $P_0/\sqrt{B_H}$ definierbare Größe? (NEP = noise equivalent power)
- d) Zerlegen Sie NEP durch den Ansatz $NEP^2 = NEP_{PIN}^2 + NEP_{Verst}^2$, und berechnen Sie beide NEP-Anteile für E= 0,5 A/W; $a = 4KT/1 M\Omega$ und $I_D= 1 nA$.

Schriftl. Prüfung / Beispiel 2

Nachrichtentechnik Hochschule Mannheim

Fach: Höchstfrequenztechnik (HT)

Tag: drei Aufg. aus verschiedenen Terminen

Hilfsmittel: Vorlesungsmitschrift, Rechner, Bücher LWL I,II

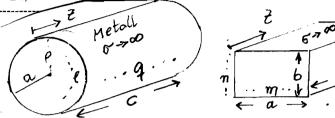
Name:

Semester 8N

Aufgabensteller: Prof. Dr. Timmermann

Bearbeitungszeit 2 h

<u>Aufg. 4</u> Bei einem Rundhohlleiter mit Wellenausbreitung in z-Richtung ist die Separationsbedingung auf den Fall eines zylindrischen Resonators umzuschreiben.



a) Schreiben Sie die bekannte Separations-

bedingung für den Rundhohlleiter und zum Vergleich auch für den Rechteckhohlleiter hin.

b) Wie ist zunächst beim Rechteckhohlleiter β² zu substituieren, wenn nun bei z=0 und z=c ideal leitende Metallflächen angebracht werden, so daß in z-Richtung q stehende Wellen entstehen. Wie ist analog beim Rundhohlleiter β² zu ersetzen, wenn dort bei z=0 und z=c ebenso die Enden mit Metallflächen geschlossen werden (Ordnungsindex sei ebenfalls q)?

c) Wie lauten die Wellentypen, und welche Resonanzfrequenzen haben die Resonatoren?

<u>Aufg. 5</u> Zu untersuchen ist ein Empfänger für intensitätsmodulierte optische Signale im Basisband. Es ist zu prüfen, ob sich eine APD anstelle einer PIN-Photodiode lohnt.

a) Wie groß ist das äquivalente Verstärkerrauschen $\sqrt{I_{ag}^2(t)}$ bei quadratisch angenommenen äquivalenten Rauschspektrum d $|\underline{I}_a|^2/df = a + b f^2$ parallel zum Primärphotostrom I_0 ?

b) Welches normierte Verstärkerrauschen N_v folgt? Wie groß ist der bestmögliche Störabstand S_Q allein durch Quantenrauschen (ohne Multipl.-rauschen / Verst.-rauschen)?

c) Berechnen Sie den optimalen Multiplikationsfaktor M_{opt} aus der exakten Lösung der kubischen Gleichung und aus der bekannten Näherung. Ist die Näherung anwendbar?

d) Welches F_A und S/N folgt für PIN und APD bei M_{opt, exakt}. Wieviel dB ist der Störabstand bei der APD besser als bei der PIN-Photodiode?

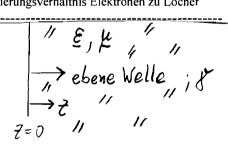
Daten:

IM-System, Basisband : m = 90 %, DC-Empfangsleistung $P_0 = 10 \text{ nW}$, Systembandbreite $B_H = 1 \text{ MHz}$

Transimpedanzverstärker : $R_f = 10 \text{ M}\Omega$, $C_t = 2 \text{ pF}$, $R_n = 1 \text{ k}\Omega$

Photodiode : E = 0.5 A/W, $I_D = 5 \text{ nA}$, k = 0.03 Ionisierungsverhältnis Elektronen zu Löcher

Aufg. 6 Ein ebene Welle tritt ab z=0 für z > 0 in einen Bereich mit gegebenem komplexen $(\underline{\varepsilon}, \underline{\mu})$ ein und breitet sich in z-Richtung aus. Es gilt dabei $\underline{\mu} = \mu' - j \mu'' = \text{reell} = \mu_r \text{ und } \underline{\varepsilon} = \epsilon' - j \epsilon'', \text{ wobei bei } \epsilon'' \text{ die Verhältnisse für sehr gute Leitfähigkeit anzusetzen sind.}$



- a) Schreiben Sie zunächst allgemein das komplexe Ausbreitungsmaß γ hin.
- b) Spezialisieren Sie nun auf ε " >> ε '.
- c) Setzen Sie nun bei ϵ '' die Verhältnisse von Metall mit einer Leitfähigkeit σ ein. Wie groß sind in $\gamma = \alpha + j\beta$ die Größen α und β ?
- d) Nach welcher Strecke $z = \delta_s$ ist die Feldstärke auf 1/e aufgefallen?